

	<p>SIE810DF-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIE810DF-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 60A POLARPAK</p>
	<p>Datenblätter:  SIE810DF-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIE810DF-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 60A POLARPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	10-PolarPAK® (L)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	10-PolarPAK® (L)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13000pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	300nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 60A (Tc) 5.2W (Ta), 125W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIE810DF-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIE810DF-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIE810DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIE810DF-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIE808DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE808DF-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 60A 10- POLARPAK</p>	 <p>SIE812DF-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A 10- POLARPAK</p>	 <p>SIE808DF-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 60A POLARPAK</p>
 <p>SIE812DF-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE810DF-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 60A 10- POLARPAK</p>	 <p>SIE812DF vishay SIE812DF vishay</p>	 <p>SIE812DF-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A 10- POLARPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIE810DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIE810DF-T1-GE3 Datenblatt	SIE810DF-T1-GE3-Datenblätter	SIE810DF-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIE810DF-T1-GE3
SIE810DF-T1-GE3 Electronic	SIE810DF-T1-GE3-Komponenten	SIE810DF-T1-GE3-Verteiler	SIE810DF-T1-GE3-Bild	SIE810DF-T1-GE3-Teil
SIE810DF-T1-GE3 Preis	SIE810DF-T1-GE3 Hersteller	SIE810DF-T1-GE3 Bild	SIE810DF-T1-GE3 Aktie	SIE810DF-T1-GE3 Inventar
SIE810DF-T1-GE3 Neu	SIE810DF-T1-GE3 Original	SIE810DF-T1-GE3 garantiert	SIE810DF-T1-GE3 RFQ	SIE810DF-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited